

БКО.347.222-02 ТУ

**573РФ2****16К (2Кх8) РЕПРОГРАММИРУЕМОЕ ПЗУ С  
УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫМ СТИРАНИЕМ ИНФОРМАЦИИ***НМОП технология*

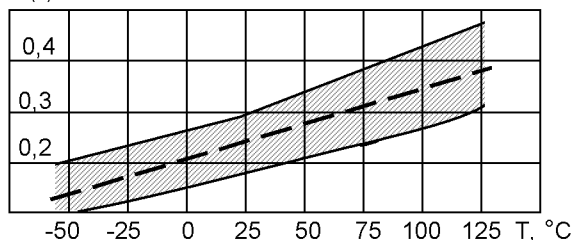
Репрограммируемое постоянное запоминающее устройство с УФ-стиранием информации обеспечивает возможность длительного хранения информации при включенном и отключенном питании и многократной смены информации.

Предназначено для работы в блоках памяти специализированных электронно-вычислительных машин, в устройствах сбора и обработки информации, устройствах информатики и контроля.

- время выборки адреса 450нс;
- напряжение питания  $5В \pm 10\%$ ;
- напряжение сигнала записи-считывания в момент программирования  $24,5В \pm 0,5В$ ;
- допустимое значение статического потенциала не более 200В.

**НАДЕЖНОСТЬ**

|                    |          |         |
|--------------------|----------|---------|
| Наработка, ч       | $t_{и}$  | 100 000 |
| Срок хранения, лет | $t_{хр}$ | 25      |

**ОБЛАСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ  $t_{A(A)}$  ОТ Т****НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ**

|                 |                 |                                   |
|-----------------|-----------------|-----------------------------------|
| 1-8, 19, 22, 23 | A1-A11          | Вход адресный                     |
| 9 -11, 13 -17   | D1-D8           | Вход-выход                        |
| 12              | OV              | Общий                             |
| 18              | $\overline{CE}$ | Вход сигнала разрешения обращения |
| 20              | $\overline{OE}$ | Вход сигнала разрешения выхода    |
| 21              | WR/RD           | Вход сигнала записи-считывания    |
| 24              | $U_{CC}$        | Источник питания                  |

**ДОПУСТИМЫЕ ВНЕШНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ****МЕХАНИЧЕСКИЕ**

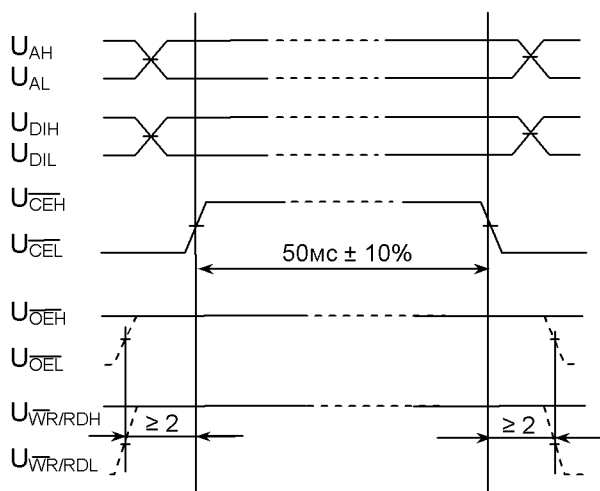
|   |        |
|---|--------|
| Механические удары, g                         | 1500   |
| Линейное ускорение, g                         | 20 000 |
| Вибрация 1 - 5 000 Гц, g                      | 40     |
| Устойчивость к воде и спирто-бензиновой смеси | 1:1    |

**КЛИМАТИЧЕСКИЕ**

|  |                |
|--|----------------|
| Диапазон рабочих температур, °C                  | от - 60 до 85  |
| Изменение температуры среды, °C                  | от - 60 до 125 |
| Повышенная влажность при $T = 35 \text{ °C}$ , % | до 98          |
| Температура пайки, °C                            | $235 \pm 5$    |
| Продолжительность, с                             | $2 \pm 0,5$    |

**ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ** ( $U_{CC} = 5 \text{ В} \pm 10\%$ )

| Символ       | Параметр  | T, °C               | 573PФ2  |
|--------------|---|---------------------|---|
| $U_{DOL}$    | Напряжение выхода низкого уровня, В<br>( $I_{OL} = 2,1 \text{ мА}$ )  | от - 60 до 85       | $\leq 0,45$                                     |
| $U_{DOH}$    | Напряжение выхода высокого уровня, В<br>( $I_{OH} = 0,4 \text{ мА}$ ) | от - 60 до 85       | $\geq 2,4$                                      |
| $I_{CC}$     | Ток потребления в режиме считывания, мА                               | 25, 85<br>- 60      | $\leq 80$<br>$\leq 110$                         |
| $I_{WR/RD}$  | Ток сигнала записи-считывания, мА                                     | 25, 85<br>- 60      | $\leq 6$<br>$\leq 10$                           |
| $I_{CCS}$    | Ток потребления в режиме хранения, мА                                 | 25, 85<br>- 60      | $\leq 21$<br>$\leq 35$                          |
| $I_{WR/RDS}$ | Ток сигнала записи-считывания в режиме хранения, мА                   | от - 60 до 85       | $\leq 2$  |
| $I_{LI}$     | Ток утечки по каждому входу, мкА                                      | от - 60 до 85       | $\leq 10$                                       |
| $t_{A(A)}$   | Время выборки адреса, мкс   | от - 60 до 85       | $\leq 0,45$                                     |
| $t_{A(CE)}$  | Время выборки разрешения обращения, мкс                               | от - 60 до 85       | $\leq 0,45$                                     |
| $t_{A(OE)}$  | Время выборки разрешения выхода, мкс                                  | от - 60 до 85       | $\leq 0,25$                                     |
| $t_{SG1}$    | Время хранения информации при отключённом питании, ч                  | 85<br>от - 60 до 25 | $\geq 25 \text{ 000}$<br>$\leq 100 \text{ 000}$ |
| $t_{SG2}$    | Время хранения информации при включённом питании, ч                   | от - 60 до 85       | $\geq 25 \text{ 000}$                           |
| $C_I$        | Входная ёмкость вывода вход-выход, пФ                                 | от - 60 до 85       | $\leq 12$                                       |
| $N_{CY}$     | Количество циклов перепрограммирования, цикл                          | $25 \pm 10$         | $\geq 100$                                      |

**ДИАГРАММА РЕЖИМА ЗАПИСИ**


Тепловое сопротивление кристалл - корпус  $0,05^\circ\text{C}/\text{мВт}$ .

Предельное значение температуры перехода (кристалла)  $130^\circ\text{C}$  при  $T_{\text{окр.ср.}} = 85^\circ\text{C}$ .

Время стирания информации, с.

$$t_{EE} = \frac{H_E}{E_E}, \quad \text{где}$$

$E_E$  – измеренное значение энергетической освещённости в плоскости окна корпуса,  $\text{Вт}/\text{м}^2$ ;  
 $H_E = 1,5 \cdot 10^5 \text{ Вт} \cdot \text{с}/\text{м}^2$  – требуемое значение энергетической экспозиции для стирания информации в микросхеме.

Стирание информации проводят путём воздействия ультрафиолетового излучения с длиной волны  $253,7 \text{ нм}$ ;

Возможна запись информации серией импульсов последовательно по одному импульсу в каждый адрес.